

PN 结 Si 光电池

描述

工作在低频区域的 Si 光电池，可接收波长处于峰值波长附近的光信号。

应用

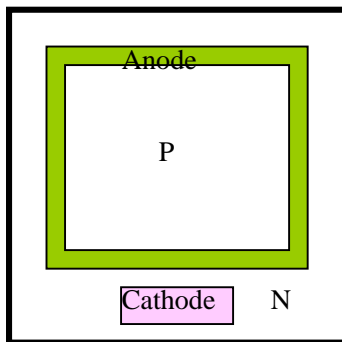
- 遥控电路
- 光纤通信

结构

芯片结构：平面 PN 型结构

电极：顶部 AlSi

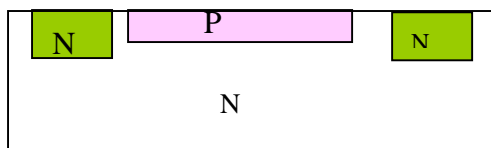
外形图和尺寸



芯片尺寸：6.0 mm × 6.0 mm

芯片厚度：300±25μm

纵向结构



芯片结构：平面 PN 型结构

电极：AlSi

光电特性 (Ta=25°)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
暗电流 Reverse dark current	I _D	V _R =10V E=0mW/cm ²			30	nA
反向击穿电压 Reverse breakdown voltage	V _{BR}	I _R =100μA, H=0mV/cm ²			50	V